



(19)

General Document.

(11) Publication number: 58140175 A

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 57023341

(51) Int'l. Cl.: H01S 3/096

(22) Application date: 16.02.82

(30) Priority:

(43) Date of application
publication:

19.08.83

(71) Applicant: TOSHIBA CORP
TOSHIBA ENG CO LTD(72) Inventor: KONISHI KUNIYOSHI
JINBO YASUHI
SHIDA KOJI(84) Designated contracting
states:

(74) Representative:

(54) ABNORMALITY
DETECTING METHOD FOR
SEMICONDUCTOR LASER
DEVICE

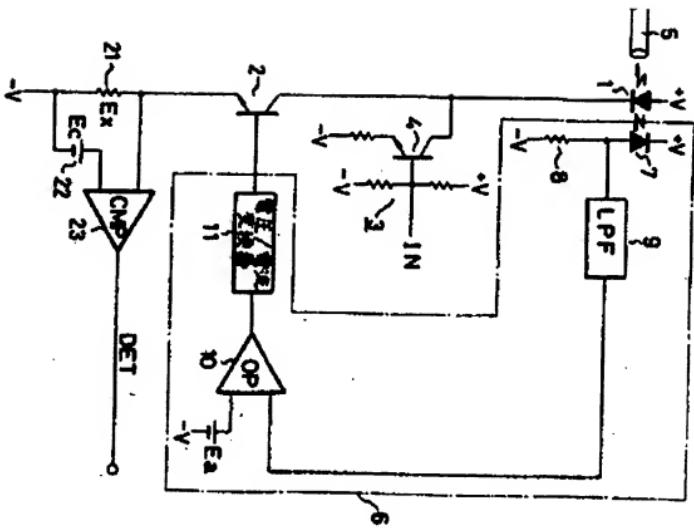
(57) Abstract:

PURPOSE: To simply determine and set the reference voltage, to be used as the condition for giving a decision for a semiconductor laser diode (LD), based on the characteristics specified in the specification for the semiconductor laser diode by a method wherein a bias current and

the reference voltage to be determined as abnormal are compared with each other.

CONSTITUTION: The photo output of the LD1 is detected and a stabilized circuit 6, with which the bias current to be supplied to the LD so as to stabilize said photo output will be variably controlled, is provided. The bias current is converted, 1 to voltage and a CMP23, with which the output voltage EX and the reference voltage 22 that was set based on the bias current value at which the LD1 will be determined as abnormal, is provided and the detection of abnormality of the LD1 is conducted based on the results of said comparison of the reference voltage 22 and the CMP23, in other words, the detection of the abnormality of LD1 is performed based on the result whether or not the actual bias current has become larger than the bias current to be determined as abnormal.

COPYRIGHT: (C)1983 JPO&Japio



⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公開
⑪ 公開特許公報 (A) 昭58-140175

⑫ Int. Cl. ³	識別記号	序内整理番号	⑬ 公開 昭和58年(1983)8月19日
H 01 S 3/096		7377-5F	
# H 01 L 33/00		6666-5F	発明の数 1
H 04 B 9/00		6442-5K	審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭ 半導体レーザダイオードの異常検出方式

⑮ 特 願 昭57-23341
 ⑯ 出 願 昭58(1982)2月16日
 ⑰ 発明者 古西邦芳
 東京都府中市東芝町1番地東京
 芝浦電気株式会社府中工場内
 ⑱ 発明者 仁保康
 東京都港区西新橋1の18の17東

芝エンジニアリング株式会社内
 ⑲ 発明者 司田浩二
 東京都港区西新橋1の18の17東
 芝エンジニアリング株式会社内
 ⑳ 出願人 東京芝浦電気株式会社
 川崎市幸区堀川町72番地
 ㉑ 出願人 東芝エンジニアリング株式会社
 東京都港区西新橋1の18の17
 ㉒ 代理人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明細書

1. 発明の名称

半導体レーザダイオードの異常検出方式

2. 特許請求の範囲

半導体レーザダイオードと、この半導体レーザダイオードにバイアス電流を供給するバイアス電流供給回路と、上記半導体レーザダイオードの光出力を検出し、一定の光出力が得られるように上記バイアス電流供給回路を制御して上記バイアス電流を可変する安定化回路と、上記バイアス電流を電圧に変換する電圧/電圧変換回路と、この電圧/電圧変換回路の出力電圧と上記半導体レーザダイオードが共巣と判定されるバイアス電流値に基づいて設定された基準電圧との大小を比較する比較器とを具備し、この比較器の比較結果によつて上記半導体レーザダイオードの異常検出を行なうことを特徴とする半導体レーザダイオードの異常検出方式。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術的背景〕

本発明は特に光伝送用の発光素子として用いられる半導体レーザダイオードの異常検出方式に関する。

〔発明の技術的背景〕

一般に半導体レーザダイオード(以下、LDと称する)は、情報伝送の超高速化および長距離化が要求される光伝送における送信部(光送信回路)の発光素子として用いられることが多い。周知のようにLDの光出力は温度依存性があるため安定性に欠ける。そこで安定化回路(以下、APCと称する)により光出力の安定化が図られるようになつてゐる。すなわち、APCはLDの光出力を検出し、この検出結果に応じてLDに供給されるバイアス電流I_Bを可変制御するもので、これによりLDの光出力の安定化が図られる。ところで、LDには経時劣化があり、このような場合、温度やバイアス電流が一定であつても時間の経過とともにLDの光出力が低下する恐れがある。通常APCはこのような劣化現象にも動作してバイアス電流

を増加せしめ一定の光出力が得られるように制御している。しかし、LD₁の劣化が進むにつれて、たとえAPCが上記バイアス電流を増加しても所定の光出力が得られなくなる。そこで、送信側において、LD₁から出力される光信号を受光素子で受け、その光出力を監視し、LD₁の劣化や故障を検出、予知する監視回路が必要である。

第1図はこのような監視機能を備えた従来の光送信回路におけるLD₁（半導体レーダダイオード）駆動回路の構成を示すもので、1はLD₁（半導体レーダダイオード）、2はLD₁にバイアス電流I_Bを供給するバイアス電流供給源としてのトランジスタである。3は変調回路である。変調回路3は入力信号INの変化に応じた電流信号を発生するトランジスタを有し、この信号を変調電流として上記バイアス電流I_Bに重畳する。LD₁はこのバイアス電流I_Bに重畳された変調電流によって駆動し、光信号を出力する。この光信号は光ファイバーケーブル

によって送信される。これにより、LD₁に供給されるバイアス電流I_Bが可変され、LD₁の光出力が一定となるように制御される。

L_PF₂の出力電圧は比較器（以下、CMPと称する）12の一方の入力端子にも供給される。CMP12の他方の入力端子には参照電圧E_Rが供給されている。この参照電圧E_Rは、LD₁が寿命あるいは故障であると判断される光出力に対応する電圧値である。CMP12はL_PF₂の出力電圧と参照電圧E_Rとを比較し、比較結果に応じた2値信号を出力する。LD₁が正常な通常状態では、LD₁の光出力はAPC₆の制御により上述したように一定に保たれており、L_PF₂の出力電圧>参照電圧E_Rである。一方、LD₁が異常となり、LD₁の光出力が低下し、APC₆の制御によりバイアス電流I_Bが増加されてもLD₁の光出力が所定出力に保たれない場合、L_PF₂の出力電圧≤参照電圧E_Rとなる。そして、この状態における比較器12の出力によってLD₁の異常が検出される。

また、LD₁から出力される光信号はPDTで検出され電気信号に変換された後、抵抗8で電圧に変換される。この抵抗8で変換された電圧はL_PF₂でその高周波成分が除去されてOP10の一方の入力端子に供給される。OP10の他方の入力端子にはLD₁の所定の光出力に対応する基準電圧E_Rが供給されている。しかしてOP10はL_PF₂の出力電圧と（所定の光出力を得るために）基準電圧E_Rとを比較し、その電圧差に応じた出力電圧を発生する。

OP10からの出力電圧は電圧／電流変換器11によって電流に変換され、バイアス制御用ベース電流としてトランジスタ3のベースに供

〔背景技術の問題点〕

このように従来のLD駆動回路では、LD₁の光出力に対応するL_PF₂の出力を監視し、このL_PF₂の出力と参照電圧E_Rとの大小比較により異常検出を行なうようになっていた。この場合、LD₁の光出力を検出するためには前述したようにLD₁とPDTを結合させ、PDTによって光／電気電圧を行なわせる必要があった。しかし、LD₁とPDTの結合には各回路毎にばらつきが生じるため、たとえLD₁の光出力が一定であってもPDTにおける光検出出力は各回路毎に異なるのが一般的であった。このため、従来のシリ駆動回路では、各回路毎に光開閉器等を用いてLD₁の光出力とPDTにおける光検出出力との関係を把握し、異常判定条件としての参照電圧を調整しなければならず、実用性に乏しい欠点があつた。

〔発明の目的〕

本発明は上記事情に鑑みてなされたものでその目的は、LD₁（半導体レーダダイオード）の

異常判定条件としての参照電圧(基準電圧)を、LDの仕様上の特性に基づいて簡便に決定し設定でき、もつてLDの異常検出が効率よく行なえる実用性に富んだ半導体レーダダイオードの異常検出方式を提供することにある。

(発明の範囲)

LD(半導体レーダダイオード)の光出力を検出し、この光出力が一定となるようにLDに供給されるバイアス電流を可変制御するAPC(安定化回路)を備えたLD駆動回路において、上記バイアス電流を電圧に変換する電圧/電圧変換回路と、この電圧/電圧変換回路の出力電圧と上記LDが異常と判定されるバイアス電流値に基づいて設定された基準電圧(参照電圧)とを比較するCMP(比較器)とを設け、このCMPの大小比較結果すなわちAPCによって制御された実際のバイアス電流が異常と判定されるバイアス電流より大きくなつたか否かによりLDの異常検出を行なうものである。

(発明の実施例)

一一致したバイアス電流 I_B によって安定している。このような状態でLD₁の電流-光出力特性が変動してLD₁の光出力が変化すると、従来例で説明したようにAPC₆の制御によりトランジスタ₂のベースに供給されるバイアス制御用ベース電流が可変される。これによりトランジスタ₂のコレクタ電流すなわちバイアス電流 I_B が可変され、LD₁の光出力が一定となるように制御される。周知のようKAPC₆は、温度変化またはLD₁の素子劣化などによりLD₁の光出力が減少するとバイアス電流 I_B が増加するよう動作し、逆にLD₁の光出力が増加するとバイアス電流が減少するよう動作する。

ところで、LD₁の素子劣化に伴つてLD₁の光出力が減少した際に、上述のようにAPC₆によってバイアス電流 I_B が増加され、所定の光出力が安定して得られるよう制御されるが、バイアス電流 I_B を充分に増やしても所定の光出力が得られない場合がある。このような状態に

以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。なお、第1回と同一部分には同一符号を付して詳細な説明を省略する。第2回のLD駆動回路において、2₁はトランジスタ₂のエミッタに接続されるバイアス電流制限抵抗である。2₂は参照電圧(基準電圧) E_C を発生する参照電圧発生回路、2₃はCMP(比較器)である。CMP₂は抵抗 2π の両端電圧 E_X と参照電圧発生回路₂で発生される参照電圧 E_C との大小を比較し、例えば $E_X \geq E_C$ の場合に論理“1”的異常検出信号DSTを出力するようになつてゐる。

次に本発明の一実施例の動作を説明する。一般にLDが発振を始める電流はスレクショルド電流 I_{th} と称されている。通常LD駆動回路ではこのスレクショルド電流 I_{th} をバイアス電流 I_B としてLD₁に定常的に供給するようになつてゐる。したがつて、第2回の構成においてLD₁の電流-光出力特性に変動が無い状態では、LD₁の光出力は上記ストレクショルド電流 I_{th}

におけるLD₁は寿命(または故障)と考えられる。上記バイアス電流 I_B は、駆動時間を t とすると一般に \sqrt{t} に比例するといわれている。そして、このバイアス電流 I_B が初期値(これはLD₁の仕様規格で定められているスレクショルド電流 I_{th} と考へてもよい)の1.5倍になつたときを一般にLD₁の寿命と称している。

そこで本実施例では、LD₁に供給されるバイアス電流 I_B が初期バイアス電流 I_{B0} の1.5倍になつたときLD₁が異常と判定されるようになつてゐる。そして、LD₁に供給されるバイアス電流 I_B と初期バイアス電流 I_{B0} の1.5倍値とを比較するために、LD₁に供給されるバイアス電流 I_B に代えて抵抗 2π の両端電圧 E_X を用い、初期バイアス電流 I_{B0} の1.5倍値に代えて以下に示す参照電圧 E_C を用い、 E_X と E_C とを比較するようになつてゐる。これは、抵抗 2π の両端電圧 E_X がバイアス電流 I_B に比例することに着目したもので、これに併せて参照電圧 E_C として初期バイアス電流 I_{B0} がLD₁に供給さ

れた場合の抵抗 Z_1 の両端電圧 E_{X_1} の1.5倍値を採用している。

CMP 2_3 は抵抗 Z_1 の両端電圧 E_{X_1} と参照電圧発生器 2_2 で発生される上記参照電圧 E_C との大小を比較する。通常 $E_{X_1} < E_C$ であるためCMP 2_3 から異常検出信号 $D_B T$ が高出力されることはない。これに対し、LD 1 の素子劣化などによりLD 1 の光出力が低下し、この光出力を所定レベルに保つようにAPC 6 の制御によってバイアス電流 I_B が増加されると、抵抗 Z_1 の両端電圧 E_{X_1} が大きくなつてくる。そして、このバイアス電流 I_B が前記初期バイアス電流 I_{B_0} の1.5倍値に一致するようになると、抵抗 Z_1 の両端電圧 E_{X_1} はあらかじめ設定されている参照電圧 E_C に一致し、これによりCMP 2_3 は有効な異常検出信号 $D_B T$ を高出力する。この異常検出信号 $D_B T$ によってLD 1 の異常、すなわちLD 1 の寿命または故障などが判断される。この場合、異常検出信号 $D_B T$ を警報器の駆動信号としたり、更には他のLDへの切換え

を実現に防止できる。これに対し、従来の方式では、バイアス電流 I_B を増加することによつてLD 1 の光出力が一定に保たれる状態では異常検出は行なわれないため、上述したLD 1 に対する保護機能を実現することは困難である。

なお、前記実施例ではバイアス電流 I_B が初期バイアス電流 I_{B_0} の1.5倍以上となることによりLD 1 の異常を判定する場合について説明したが、これに限られるものではない。また、前記実施例では、バイアス電流 I_B の電流/電圧変換器としてトランジスタ 2 のエミッタを接続される(バイアス電流制限)抵抗 Z_1 を用いた場合について説明したが、トランジスタ 2 、 4 のコレクタ間に抵抗を挿入し、この抵抗の両端電圧と参照電圧とを比較するようにしてもよい。

(発明の効果)

以上詳述したように本発明のレーザダイオードの異常検出方式によれば、半導体レーザダイオードの異常判定条件としての参照電圧(基準電圧)の設定が極めて簡単に行なえるので、実

を行なう切換回路に対する切換制御信号とすることは可能である。

本実施例で適用される参照電圧 E_C は、上述したように初期バイアス電流 I_{B_0} により発生する抵抗 Z_1 の両端電圧を1.5倍した値である。一般にこの初期バイアス電流 I_{B_0} として、LD 1 の仕様上の特性で示されているスレクショルド電流 I_{th} が採用されており、このスレクショルド電流 I_{th} 、抵抗 Z_1 の抵抗値 R に基づいて、従来のように調整等を行なうことなく参照電圧 E_C を決定することができる。この場合、トランジスタ 2 のベース接地電流増幅率を α とすると

$$E_C = 1.5 \times (\alpha \times I_{th} \times R)$$

となる。

また、本実施例によれば、APC 6 の故障により、LD 1 に供給されるバイアス電流 I_B が急増した場合などにも、その旨をCMP 2_3 から高出力される異常検出信号 $D_B T$ によつて検知できることで、これに対処することによりバイアス電流 I_B の急増のためにLD 1 が破壊されること

を実現に防止できる。これに対し、従来の方式では、バイアス電流 I_B を増加することによつてLD 1 の光出力が一定に保たれる状態では異常検出は行なわれないため、上述したLD 1 に対する保護機能を実現することは困難である。

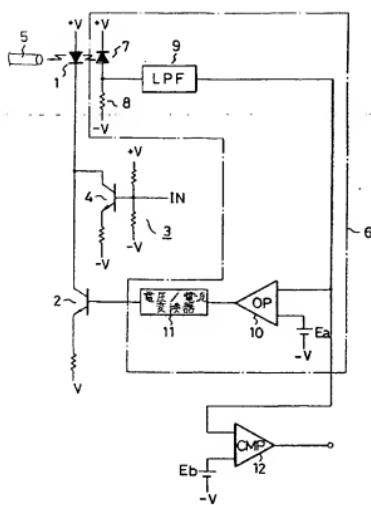
4. 図面の簡単な説明

第1図は従来例を示す回路構成図、第2図は本発明の一実施例を示す回路構成図である。

1…半導体レーザダイオード(LD)、2…トランジスタ(バイアス電流供給回路)、6…安定化回路(APC)、7…フォトダイオード(PD)、12、23…比較器(CMP)、21…バイアス電流制限抵抗(電流/電圧変換器)、22…参照電圧発生器。

出願人代理人 井理士 鮎江武蔵

第 1 図



第 2 四

